

Реєстраційна картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0102U0000087

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 12-01-2002

II. Підстава для проведення робіт

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК):

У тому числі по роках:
Загальний обсяг фінансування: 68 тис. грн.

III. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги, 10, м. Київ, Київ, 01135, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0442878922, 0442878922

IV. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: пр. Науки, 41, м. Київ, Київська обл., 03028, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380445254020

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Багаточастинкові ефекти в гетероструктурах з квантовими ямами

Назва роботи англійською:

Many-body effects in quantum well heterostructures

Мета роботи українською:

Визначення механізмів утворення багаточастинкових екситонів в квантових гетероструктурах за умов зміни густини збудження, температури та магнітного поля, визначення впливу міжточкової взаємодії на характер електрон-діркових кореляцій, розробка ефективних неруйнівних методів контролю гетероструктур.

Мета роботи англійською:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Будуть встановлені спеціальні умови для розвитку багаточастинкових екситонів, що включають компроміс між локалізацією дірки, температурою, інтенсивністю збудження та величиною магнітного поля. Будуть деталізовані механізми їх утворення в гетероструктурах на основі квантових ям, точок, дрітків. Буде встановлена кореляція між величиною багаточастинкових ефектів та ступенем розупорядкування квантової ями.

Галузь застосування:

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Тарасов Георгій Григорович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Вирощування та характеристика квантових модульовано легованих гетероструктур AlGaAs/InGaAs/GaAs, InAs/GaAs, In As/InP

Початок етапу: 06.2001

Закінчення етапу: 12.2006

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

Індекс УДК: 538.9, 538.94

Коди тематичних рубрик: 29.19.03

IX. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Свечніков Сергій Васильович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

Юрченко Т.А.

